

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成20年5月22日(2008.5.22)

【公開番号】特開2002-49333(P2002-49333A)

【公開日】平成14年2月15日(2002.2.15)

【出願番号】特願2001-142693(P2001-142693)

【国際特許分類】

G 0 9 F	9/30	(2006.01)
H 0 1 L	27/32	(2006.01)
H 0 5 B	33/02	(2006.01)
H 0 5 B	33/04	(2006.01)
H 0 5 B	33/08	(2006.01)
H 0 1 L	51/50	(2006.01)
H 0 5 B	33/22	(2006.01)

【F I】

G 0 9 F	9/30	3 6 5 Z
G 0 9 F	9/30	3 3 8
H 0 5 B	33/02	
H 0 5 B	33/04	
H 0 5 B	33/08	
H 0 5 B	33/14	A
H 0 5 B	33/22	Z

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

画素部および駆動回路を同一の絶縁体上に含む発光装置において、
前記画素部にはスイッチング素子および電流制御素子が設けられ、
前記駆動回路にはインバータ回路が設けられ、

前記スイッチング素子、前記電流制御素子および前記インバータ回路を構成するTFT
が有する半導体膜は全てn型であることを特徴とする発光装置。

【請求項2】

画素部および駆動回路を同一の絶縁体上に含む発光装置において、
前記駆動回路はエンハンスマント型のnチャネル型TFTおよびデプレーション型のn
チャネル型TFTで形成された複数のフリップフロップ回路からなるシフトレジスタを含
み、

前記画素部及び前記駆動回路を構成するTFTが有する半導体膜は全てn型であることを
特徴とする発光装置。

【請求項3】

画素部および駆動回路を同一の絶縁体上に含む発光装置において、
前記駆動回路はエンハンスマント型のnチャネル型TFTおよびデプレーション型のn
チャネル型TFTで形成された複数のフリップフロップ回路からなるシフトレジスタ並び
にエンハンスマント型のnチャネル型TFTおよびデプレーション型のnチャネル型TFT

Tで形成された複数のNAND回路を含み、

前記画素部及び前記駆動回路を構成するTFTが有する半導体膜は全てn型であることを特徴とする発光装置。

【請求項4】

画素部および駆動回路を同一の絶縁体上に含む発光装置において、

前記画素部は複数の画素を含み、

前記画素には複数のエンハンスマント型のnチャネル型TFTおよびデプレーション型のnチャネル型TFTが設けられ、

前記画素部及び前記駆動回路を構成するTFTが有する半導体膜は全てn型であることを特徴とする発光装置。

【請求項5】

画素部および駆動回路を同一の絶縁体上に含む発光装置において、

前記画素部は複数の画素を含み、

前記画素には複数のエンハンスマント型のnチャネル型TFTおよびデプレーション型のnチャネル型TFTで形成されたSRAMが設けられ、

前記画素部及び前記駆動回路を構成するTFTが有する半導体膜は全てn型であることを特徴とする発光装置。

【請求項6】

請求項1乃至請求項5のいずれか一において、前記絶縁体は両面もしくは片面に保護膜を設けたプラスチック基板であることを特徴とする発光装置。

【請求項7】

請求項1乃至請求項6のいずれか一において、前記半導体素子は薄膜トランジスタであることを特徴とする発光装置。

【請求項8】

請求項1乃至請求項7のいずれか一において、前記駆動回路は少なくとも2つのエンハンスマント型のnチャネル型TFTで構成されるインバータ回路もしくは少なくともエンハンスマント型のnチャネル型TFTとデプレーション型のnチャネル型TFTで構成されるインバータ回路を含むことを特徴とする発光装置。

【請求項9】

請求項1乃至請求項8のいずれか一において、前記画素部は複数の画素を含み、該複数の画素にEL素子が設けられていることを特徴とする発光装置。

【請求項10】

請求項1乃至請求項9のいずれか一に記載の発光装置を用いたことを特徴とする電気器具。

【請求項11】

請求項1乃至請求項10のいずれか一に記載の発光装置を用いたことを特徴とするデジタルカメラ。

【請求項12】

請求項1乃至請求項11のいずれか一に記載の発光装置を用いたことを特徴とする携帯電話。